



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202930383 U

(45) 授权公告日 2013.05.08

(21) 申请号 201220686777.4

(22) 申请日 2012.12.12

(73) 专利权人 京东方科技股份有限公司

地址 100015 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

(72) 发明人 宋泳锡 刘圣烈 崔承镇 金熙哲

(74) 专利代理机构 北京路浩知识产权代理有限公司 11002

代理人 王莹

(51) Int. Cl.

H01L 27/12(2006.01)

H01L 27/32(2006.01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

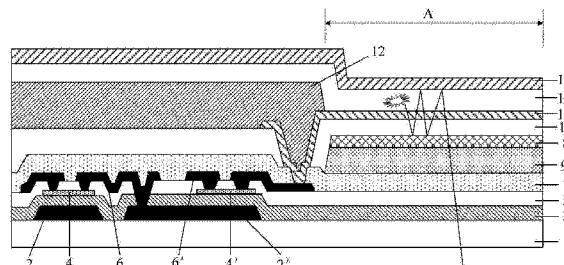
权利要求书2页 说明书5页 附图5页

(54) 实用新型名称

阵列基板及显示装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种阵列基板，包括多个位于基板上的像素单元，像素单元包括：形成在基板上的薄膜晶体管结构；以及由薄膜晶体管结构驱动的有机发光二极管，有机发光二极管位于像素单元的像素区域，有机发光二极管在远离基板的方向上依次包括透明的第一电极、发光层、反射光线的第二电极；彩膜，位于所述有机发光二极管与所述薄膜晶体管结构之间；半反半透层，位于所述有机发光二极管的第二电极与所述彩膜之间；有机发光二极管的第二电极与半反半透层形成微腔结构。还公开了包括上述阵列基板的显示装置。本实用新型在阵列基板上实现了结构，制作工艺简单的微腔结构。



1. 一种阵列基板，包括多个位于基板上的像素单元，所述像素单元包括：

形成在基板上的薄膜晶体管结构；

以及由所述薄膜晶体管结构驱动的有机发光二极管，所述有机发光二极管位于所述像素单元的像素区域，所述有机发光二极管在远离基板的方向上依次包括透明的第一电极、发光层、反射光线的第二电极；

彩膜，位于所述有机发光二极管与所述薄膜晶体管结构之间；

半反半透层，位于所述有机发光二极管的第二电极与所述彩膜之间；

所述有机发光二极管的第二电极与所述半反半透层形成微腔结构。

2. 如权利要求 1 所述的阵列基板，其特征在于，所述薄膜晶体管结构包括：形成在基板上的第一栅极、第二栅极，形成在所述第一栅极和第二栅极之上的栅绝缘层，形成在所述栅绝缘层之上的第一有源层和第二有源层，形成在第一有源层之上的第一源极和第一漏极，形成在第二有源层之上的第二源极和第二漏极，所述第一漏极连接所述第二栅极，所述第一栅极、栅绝缘层、第一有源层、第一源极及第一漏极形成开关薄膜晶体管，所述第二栅极、栅绝缘层、第二有源层、第二源极及第二漏极形成驱动薄膜晶体管；

所述驱动薄膜晶体管的第二漏极与所述有机发光二极管的第一电极电连接。

3. 如权利要求 2 所述的阵列基板，其特征在于，所述薄膜晶体管结构之上还形成有钝化层；所述有机发光二极管形成在所述钝化层的上方，所述有机发光二极管的第二电极为阴极，第一电极为阳极，且所述阳极通过所述钝化层的过孔连接第二漏极，所述彩膜形成在所述钝化层之上，所述半反半透层形成在所述彩膜之上，所述半反半透层和彩膜均位于所述像素单元的像素区域，所述发光二极管的阳极位于所述半反半透层上方。

4. 如权利要求 2 所述的阵列基板，其特征在于，所述薄膜晶体管结构之上还形成有钝化层；所述有机发光二极管形成在所述钝化层的上方，所述有机发光二极管的第一电极为阴极，第二电极为阳极，且所述阴极通过所述钝化层的过孔连接第二漏极，所述彩膜形成在所述钝化层之上，所述半反半透层形成在所述彩膜之上，所述半反半透层和彩膜均位于所述像素单元的像素区域，所述有机发光二极管的阴极位于所述半反半透层上方。

5. 如权利要求 3 或 4 所述的阵列基板，其特征在于，所述半反半透层靠近所述有机发光二极管的一侧的表面为由若干凹凸结构或波浪结构排成阵列形成的面。

6. 如权利要求 5 所述的阵列基板，其特征在于，所述彩膜靠近所述有机发光二极管的一侧的表面为由若干凹凸结构或波浪结构排成阵列形成的凹凸面，半反半透层形成在所述凹凸面上，且半反半透层的厚度相同。

7. 如权利要求 3 或 4 所述的阵列基板，其特征在于，所述半反半透层和所述第一电极之间还设有树脂层，所述第一电极通过穿过树脂层及钝化层的过孔连接所述第二漏极。

8. 如权利要求 1 所述的阵列基板，其特征在于，在所述像素单元的所述薄膜晶体管结构对应区域，且位于所述第一电极之上还形成有像素定义层。

9. 如权利要求 1 所述的阵列基板，其特征在于，所述半反半透层由银、铝、钼、铜、钛、铬中的任意一种金属或它们中任意两种或以上的合金构成，且透过率为 5%~95%。

10. 如权利要求 1 所述的阵列基板，其特征在于，所述半反半透层厚度为：

10 Å ~ 200 Å

11. 如权利要求 1 所述的阵列基板，其特征在于，所述彩膜的厚度为：

1000 Å ~ 40000Å。

12. 如权利要求 1 所述的阵列基板, 其特征在于, 所述彩膜包括 : 红绿蓝、红绿蓝黄或红绿蓝白模式的彩膜。

13. 一种显示装置, 其特征在于, 包括如权利要求 1~12 中任一项所述的阵列基板。

阵列基板及显示装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及显示技术领域,特别涉及一种阵列基板及显示装置。

背景技术

[0002] 有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diodes,OLED)以其制备工艺简单、成本低、发光颜色可在可见光区内任意调节以及易于大面积和柔性弯曲等优点,被认为是未来最重要的显示技术之一。尤其是白光OLED(WOLED)的功率效率已经超过了 60lm/W ,寿命达到了2万个小时以上,极大地推动了WOLED的发展。

[0003] 如图1中(a)所示,其中一种WOLED采用红绿蓝三基色掺杂成有机发光层102,使得有机发光层102发出白光,有机发光层102位于阴极101和阳极103之间,发光层发出的白光通过阴极101反射后从阳极103的一侧出射。为了提高光的透过率,增大WOLED显示装置的亮度,在阳极的一侧,且对应彩膜上每一种颜色滤光片的区域各设有半反半透层103',从而形成微腔结构(microcavity structure),如图1中(b)所示,微腔结构是指在一反射层和一半反半透层间形成的厚度为微米量级的结构,其加强光的强度的原理为:光线会在层中不断反射,由于谐振作用,故最终从半反半透层射出的光线中特定波长的光会得到加强,而该得到加强的波长与微腔厚度有关。在白光有机发光二极管显示装置中,不同像素单元是用于发出不同颜色的光的,因此不同像素单元中的微腔应能使不同波长的光(与微腔外对应的彩膜颜色相同的光)获得增强,即不同像素单元中的微腔厚度不同。

[0004] 如图2和3所示为现有的两种WOLED阵列基板的层次结构示意图,彩膜位于微腔结构的外部,由上述原理可知彩膜上每种颜色对应的微腔结构厚度不一样,如图2中的300和图3中的400。由于各色光的波长不一样,其对应的微腔结构也不尽相同,厚度的也不同。例如图3中,Cathode为有机发光二极管的阴极,Anode为阳极,两者之间为发白光的有机发光层(通常采用RGB三原色的有机材料混合而成)。R、G、B及W分别代表红光、绿光、蓝光及白光的出光区域,Red CF、Green CF和Blue CF分别为彩膜上红色、绿色及蓝色的滤光片。各色光的微腔结构都包括位于OC层(保护层)上方的IZO或ITO层,对于R、G、B,还包括SiNx及SiOx(硅的氮化物及硅的氧化物)层,对于R和B还包括除了阳极以外的IZO/ITO层,WOLED发出的白光透过上述各层后,对应色光的透过率会增大。如图4所示,点线对应无微腔结构时的透过率(即亮度),实线对应有微腔结构的透过率,对于蓝光透过率大约为原来的1.6倍,对于绿光透过率大约为原来的2.5倍,对于红光透过率大约为原来的2.2倍。

[0005] 由图2和图3可看出,虽然现有的微腔结构增大了光的透过率,但现有的微腔结构层次结构比较复杂,而且每个颜色的滤光片对应的区域制作不同厚度的微腔结构,制作工艺较复杂。

实用新型内容

[0006] (一)要解决的技术问题

[0007] 本实用新型要解决的技术问题是：如何实现制作工艺简单的微腔结构，从而增大WOLED 显示装置的透过率。

[0008] (二) 技术方案

[0009] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种阵列基板，包括多个位于基板上的像素单元，所述像素单元包括：

[0010] 形成在基板上的薄膜晶体管结构；

[0011] 以及由所述薄膜晶体管结构驱动的有机发光二极管，所述有机发光二极管位于所述像素单元的像素区域，所述有机发光二极管在远离基板的方向上依次包括透明的第一电极、发光层、反射光线的第二电极；

[0012] 彩膜，位于所述有机发光二极管与所述薄膜晶体管结构之间；

[0013] 半反半透层，位于所述有机发光二极管的第二电极与所述彩膜之间；

[0014] 所述有机发光二极管的第二电极与所述半反半透层形成微腔结构。

[0015] 其中，所述薄膜晶体管结构包括：形成在基板上的第一栅极、第二栅极，形成在所述第一栅极和第二栅极之上的栅绝缘层，形成在所述栅绝缘层之上的一第一有源层和第二有源层，形成在第一有源层之上的一第一源极和第一漏极，形成在第二有源层之上的一第二源极和第二漏极，所述第一漏极连接所述第二栅极，所述第一栅极、栅绝缘层、第一有源层、第一源极及第一漏极形成开关薄膜晶体管，所述第二栅极、栅绝缘层、第二有源层、第二源极及第二漏极形成驱动薄膜晶体管；

[0016] 所述驱动薄膜晶体管的第二漏极与所述有机发光二极管的第一电极电连接。

[0017] 其中，所述薄膜晶体管结构之上还形成有钝化层；所述有机发光二极管形成在所述钝化层的上方，所述有机发光二极管的第二电极为阴极，第一电极为阳极，且所述阳极通过所述钝化层的过孔连接第二漏极，所述彩膜形成在所述钝化层之上，所述半反半透层形成在所述彩膜之上，所述半反半透层和彩膜均位于所述像素单元的像素区域，所述发光二极管的阳极位于所述半反半透层上方。

[0018] 其中，所述薄膜晶体管结构之上还形成有钝化层；所述有机发光二极管形成在所述钝化层的上方，所述有机发光二极管的第一电极为阴极，第二电极为阳极，且所述阴极通过所述钝化层的过孔连接第二漏极，所述彩膜形成在所述钝化层之上，所述半反半透层形成在所述彩膜之上，所述半反半透层和彩膜均位于所述像素单元的像素区域，所述有机发光二极管的阴极位于所述半反半透层上方。

[0019] 其中，所述半反半透层靠近所述有机发光二极管的一侧的表面为由若干凹凸结构或波浪结构排成阵列形成的面。

[0020] 其中，所述彩膜靠近所述有机发光二极管的一侧的表面为由若干凹凸结构或波浪结构排成阵列形成的凹凸面，半反半透层形成在所述凹凸面上，且半反半透层的厚度相同。

[0021] 其中，所述半反半透层和所述第一电极之间还设有树脂层，所述第一电极通过穿过树脂层及钝化层的过孔连接所述第二漏极。

[0022] 其中，在所述像素单元的所述薄膜晶体管结构对应区域，且位于所述第一电极之上还形成有像素定义层。

[0023] 其中，所述半反半透层由银、铝、钼、铜、钛、铬中的任意一种金属或它们中任意两种或以上的合金构成，且透过率为 5%~95%。

- [0024] 其中,所述半反半透层厚度为:10 Å ~ 200Å。
- [0025] 其中,所述彩膜的厚度为:1000 Å ~ 40000Å。
- [0026] 其中,所述彩膜包括:红绿蓝、红绿蓝黄或红绿蓝白模式的彩膜。
- [0027] 本实用新型还提供了一种显示装置,包括上述任一项所述的阵列基板。
- [0028] (三)有益效果
- [0029] 本实用新型通过在半反半透层与有机发光二极管的反射电极(阴极或阳极)之间形成厚度一致的微腔结构,在一定程度上增大了光的透过率。

附图说明

- [0030] 图 1 中(a)是现有的无微腔结构的有机发光二极管示意图,(b)是现有的微腔结构原理示意图;
- [0031] 图 2 是现有的一种带有微腔结构的 WOLED 阵列基板结构示意图;
- [0032] 图 3 是现有的另一种带有微腔结构的 WOLED 阵列基板结构示意图;
- [0033] 图 4 是微腔结构对透过率的提升曲线示意图;
- [0034] 图 5 是本实用新型实施例的一种阵列基板结构示意图;
- [0035] 图 6 是本实用新型实施例的另一种阵列基板结构示意图;
- [0036] 图 7 是制作图 5 的阵列基板的方法流程中在基板上形成薄膜晶体管结构的示意图;
- [0037] 图 8 是在图 7 的基板基础上形成彩膜图形的示意图;
- [0038] 图 9 是在图 8 的基板基础上形成半反半透层图形的结构示意图;
- [0039] 图 10 是在图 9 的基板基础上形成树脂层图形的结构示意图;
- [0040] 图 11 是在图 10 的基板基础上形成阳极的结构示意图;
- [0041] 图 12 是在图 11 的基板基础上形成像素定义层图形的结构示意图。

具体实施方式

[0042] 下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

[0043] 如图 5 所示,本实施例的阵列基板包括:形成在基板 1 上的多条栅线、数据线及栅线和数据线交叉形成的像素单元。像素单元包括:形成在基板上的薄膜晶体管结构及由薄膜晶体管结构驱动的有机发光二极管,有机发光二极管位于像素单元的像素区域(通常指除薄膜晶体管结构以外的显示区域),即图 5 中 A 区域。像素单元还包括彩膜 9。有机发光二极管在远离基板 1 的方向上依次包括透明的第一电极 11、发光层 13、反射光线的第二电极 14。

[0044] 为了实现微腔结构,本实施例阵列基板的像素单元中还包括半反半透层 8。半反半透层 8 位于有机发光二极管与彩膜 9 之间。有机发光二极管的第二电极 14 与半反半透层 8 形成微腔结构。光在微腔中反射过程中,由于谐振作用,使得一部分光线加强后出射,在一定程度上提高了透过率。

[0045] 薄膜晶体管结构具体如图 5 所示,包括:形成在基板 1 上的第一栅极 2、第二栅极 2' 及栅线(图中未示出),形成在第一栅极 2、第二栅极 2' 及栅线之上的栅绝缘层 3,形成

在栅绝缘层 3 上的第一有源层 4 和第二有源层 4'，形成在第一有源层 4 和第二有源层 4' 之上的绝缘层 5，形成在绝缘层 5 上的第一源漏层 6（包括第一源极和第一漏极）和第二源漏层 6'（包括第二源极和第二漏极），形成在第一源漏层 6 和第二源漏层 6' 之上的钝化层 7。其中，第一栅极 2、栅绝缘层 3、第一有源层 4、绝缘层 5 及第一源漏层 6 形成开关薄膜晶体管，第二栅极 2'、栅绝缘层 3、第二有源层 4'、绝缘层 5 及第二源漏层 6' 形成驱动薄膜晶体管。

[0046] 本实施例中，彩膜 9 形成在钝化层 7 之上，半反半透层 8 形成在彩膜 9 之上。有机发光二极管位于半反半透层 8 和彩膜 9 的上方，且通过像素定义层（Pixel Define Layer，PDL）12 形成在像素区域 A。本实施例中，第一电极 11 为阳极，第二电极 14 为阴极（也可以是：第一电极 11 为阴极，第二电极 14 为阳极），第一电极 11 通过钝化层 7 上的过孔连接第二漏极。第二电极 14 可以是由反射材料制作的反射电极，也可以是在第二电极 14 上涂有反射层形成反射电极。

[0047] 开关薄膜晶体管的栅极（第一栅极 2）连接栅线，源极（第一源极）连接数据线，漏极（第一漏极）连接驱动薄膜晶体管的栅极（第二栅极 2'），驱动薄膜晶体管的源极（第二源极）连接电源电压，漏极（第二漏极）连接有机发光二极管的第一电极 11。白光有机发光层 13 发出的白光透过第一电极 11 及以下的各层后从基板 1 底部出射，如图 5 所示。当白光照射到半反半透层 8 后，一部分光线出射，一部分光线反射，反射的光线再经过第二电极 14 反射，反射光在半反半透层 8 和第二电极 14 之间反射过程中，由于谐振作用，故最终从半反半透层 8 射出的光线中对应颜色波长的光会得到加强，从而增大透过率。

[0048] 进一步地，为了使出光更加均匀，如图 6 所示，彩膜 9 靠近有机发光二极管的一侧的表面为由若干凹凸结构或波浪结构排成阵列形成的凹凸面。由于在彩膜 9 上形成半反半透层 8 的厚度相同，这样使得其上的半反半透层 8 的表面也为若干凹凸结构或波浪结构排成阵列形成的面（当然也可以直接在半反半透层 8 的反射面上制作凹凸结构或波浪结构）。光在凹凸的反射面上的反射角度不同，呈四面八方反射的效果，从而使得出光更均匀。

[0049] 为了增大微腔结构的空间距离，进一步增大透过率，在半反半透层 8 和阳极 11 之间还形成有树脂层 10，第一电极 11 通过穿过钝化层 7 和树脂层 10 的过孔连接第二漏极。

[0050] 本实施例中，半反半透层 8 由银、铝、钼、铜、钛、铬中的任意一种金属或它们中任意两种或以上的合金构成，其透过率为 5%~95%；厚度为 $10\text{Å} \sim 200\text{Å}$ 。彩膜 9 的厚度为： $1000\text{Å} \sim 40000\text{Å}$ ，彩膜 9 可以为：红绿蓝、红绿蓝黄或红绿蓝白模式的彩膜。

[0051] 制作上述阵列基板的方法包括：

[0052] 步骤一：在基板 1 上形成包括薄膜晶体管结构及钝化层 7 的图形，以确定基板 1 上的多个像素单元。该步骤主要通过形成（可以是涂敷、溅射、沉积等多种方式）相应的膜层，然后通过构图工艺（构图工艺通常包括光刻胶涂敷、曝光、显影、刻蚀、光刻胶剥离等工艺）形成相应层的图形，该步骤与现有的制作阵列基板的步骤基本相同，此处不再赘述。该步骤形成后的基板如图 7 所示，示出了一个像素单元的结构，薄膜晶体管结构所在的区域为非像素区域，像素区域为 A。薄膜晶体管结构包括：开关薄膜晶体管和驱动薄膜晶体管，其中，由第一栅极 2、栅绝缘层 3、第一有源层 4、绝缘层 5 及第一源漏层 6（包括第一源极和第一漏极层）形成开关薄膜晶体管；由第二栅极 2'、栅绝缘层 3、第二有源层 4'、绝缘层 5 及第二源漏层 6'（包括第二源极和第二漏极层）形成驱动薄膜晶体管。

[0053] 步骤二：如图 8 和 9 所示，在像素单元的像素区域 A 形成半反半透层 8 及彩膜 9 的图形，使半反半透层 8 位于彩膜 9 之上。该步骤具体包括：

[0054] 彩膜 9 的形成是分多次(RGB 为 3 次)形成，每一次形成一种颜色滤光片的图形，逐次形成其它颜色滤光片的图形，从而形成彩膜 9 的图形。具体方式为：在钝化层 7 上形成一种颜色的彩色滤光薄膜，通过构图工艺在像素区域 A 形成该颜色滤光片的图形。按该方式逐次形成其它颜色滤光片的图形，从而形成彩膜 9 的图形。优选的，彩膜 9 的厚度在 $1000\text{Å} \sim 40000\text{Å}$ 之间。

[0055] 在彩膜 9 上形成半反半透薄膜，半反半透薄膜由银、铝、钼、铜、钛、铬中的任意一种金属或它们中任意两种或以上的合金构成，其厚度为 $10\text{Å} \sim 200\text{Å}$ ，透过率为 5%~95%。形成半反半透薄膜后通过构图工艺在像素区域 A 形成半反半透层 8 的图形。

[0056] 进一步地，在形成每种颜色的彩色滤光薄膜时，在该薄膜靠近有机发光二极管一侧的表面形成若干凹凸结构或波浪结构。再在形成凹凸结构或波浪结构的表面形成厚度一致的半反半透薄膜，以使形成的半反半透层 8 的表面具有若干凹凸结构或波浪结构。

[0057] 步骤三：在像素单元的像素区域 A 形成有机发光二极管，使半反半透层 8 和彩膜 9 位于有机发光二极管和薄膜晶体管结构之间。该步骤具体包括：

[0058] 如图 10 所示，通过构图工艺在钝化层 7 上刻蚀形成过孔。为了增大微腔结构的空间距离，进一步增大透过率，还可以在钝化层 7 上形成树脂层 10，过孔穿过钝化层 7 和树脂层 10。

[0059] 如图 11 所示，形成透明导电薄膜，通过构图工艺形成有机发光二极管的第一电极 11 的图形，使第一电极 11 通过过孔连接薄膜晶体管结构，具体连接驱动薄膜晶体管的漏极。

[0060] 如图 12 所示，形成绝缘薄膜，通过构图工艺形成像素定义层 12 的图形，以将待形成的有机发光二极管的位置定义在像素区域 A；

[0061] 形成有机发光层 13 及有机发光二极管的第二电极 14，从而形成有机发光二极管，最终形成的阵列基板如图 5 所示。第二电极 14 为反射电极，在制作时可采用反射材料形成，或在形成第二电极 14 之前形成反射层，再将第二电极 14 形成在反射层上，或形成第二电极 14，再在第二电极 14 上形成反射层。

[0062] 本实用新型还提供了一种显示装置，包括上述的阵列基板。所述显示装置可以为：电子纸、OLED 面板、OLED 显示器、OLED 电视、数码相框、手机、平板电脑等任何具有显示功能的产品或部件。

[0063] 以上实施方式仅用于说明本实用新型，而并非对本实用新型的限制，有关技术领域的普通技术人员，在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下，还可以做出各种变化和变型，因此所有等同的技术方案也属于本实用新型的范畴，本实用新型的专利保护范围应由权利要求限定。

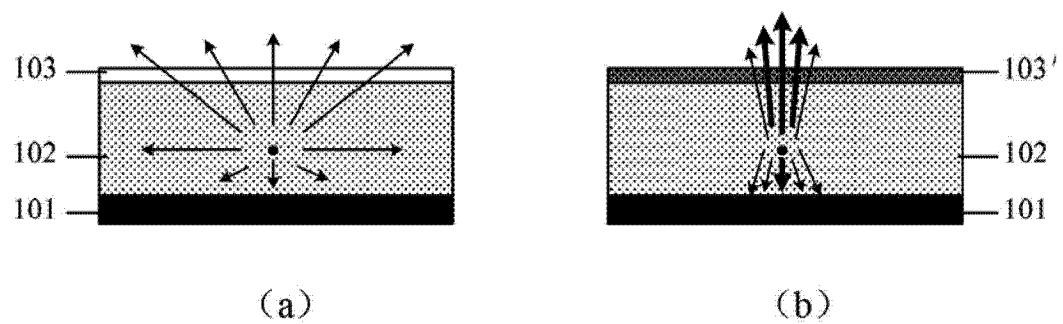


图 1

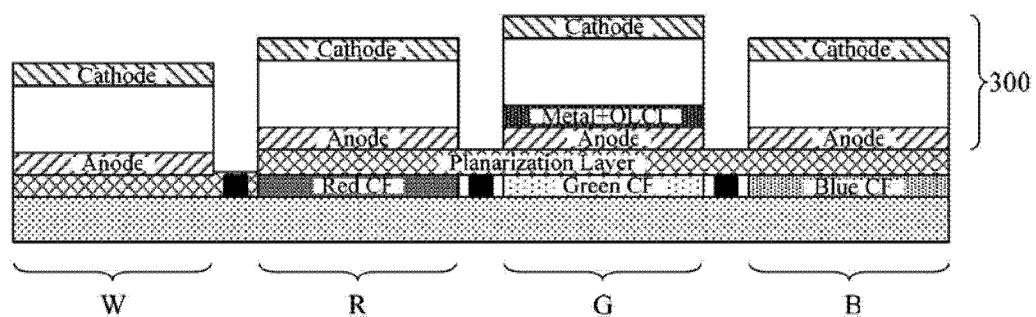


图 2

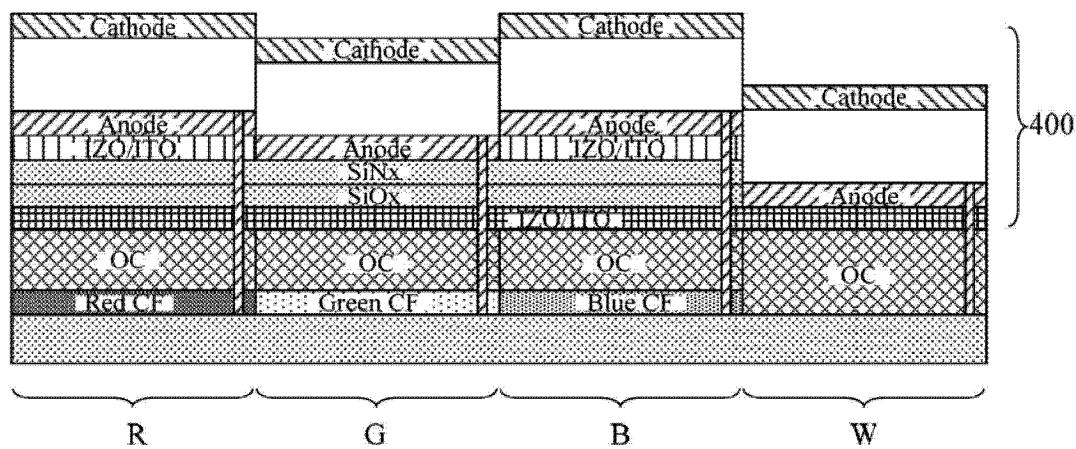


图 3

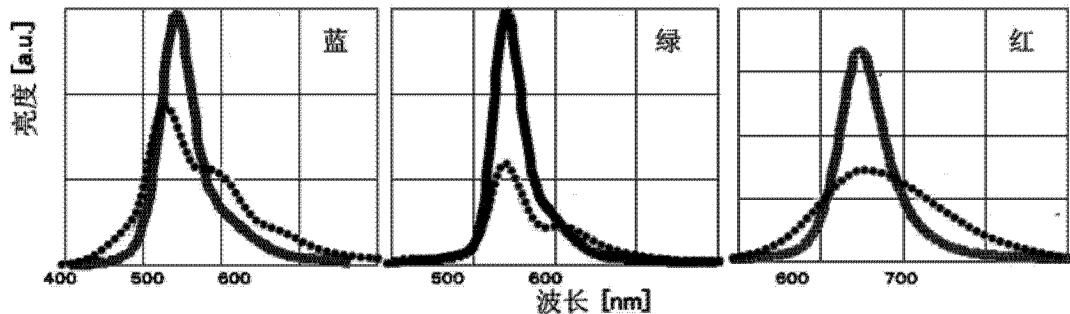


图 4

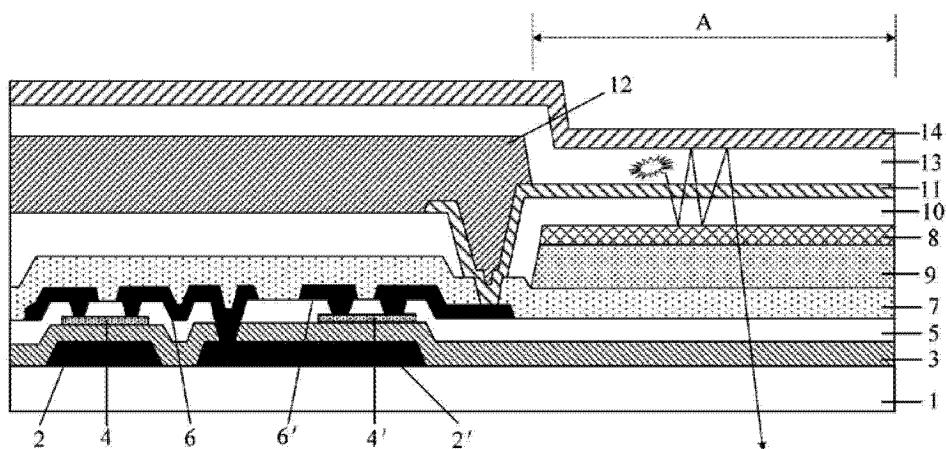


图 5

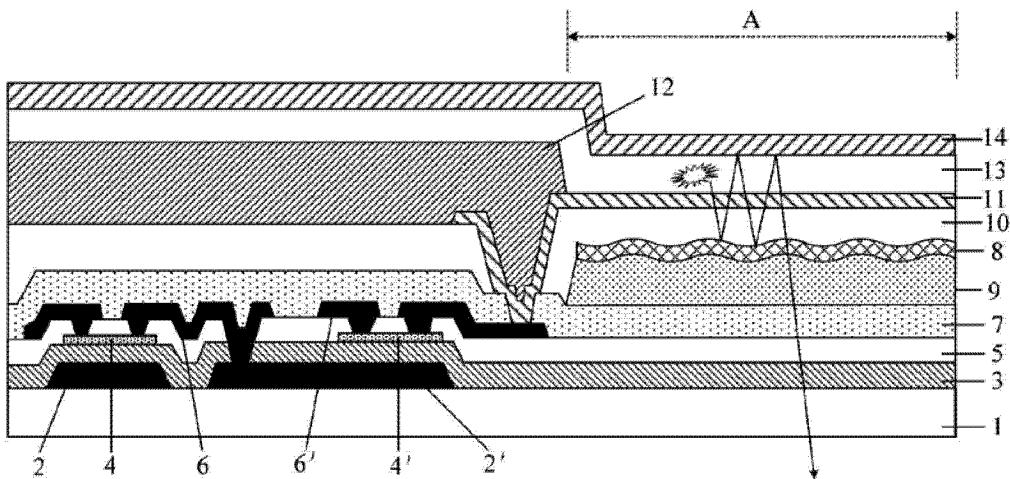


图 6

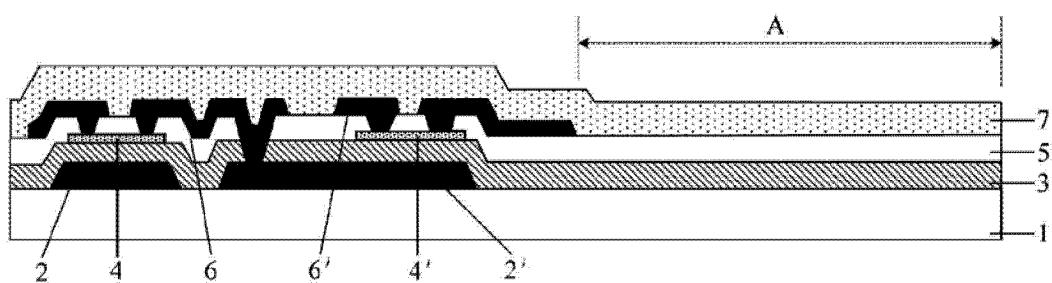


图 7

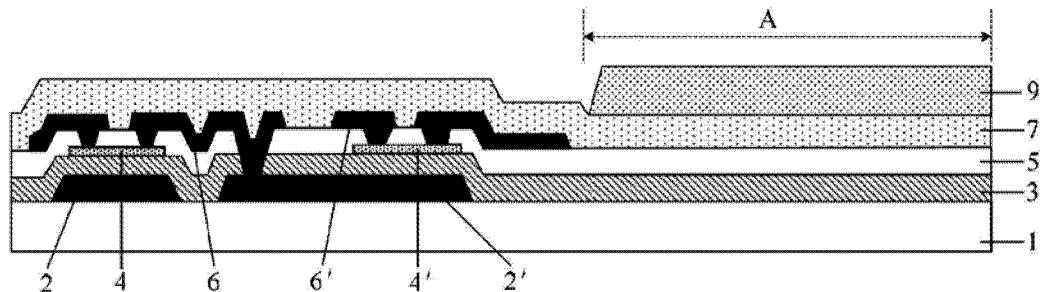


图 8

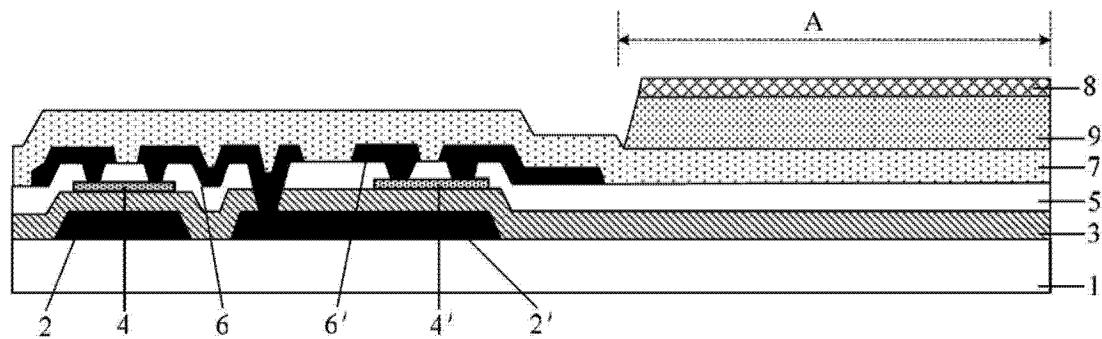


图 9

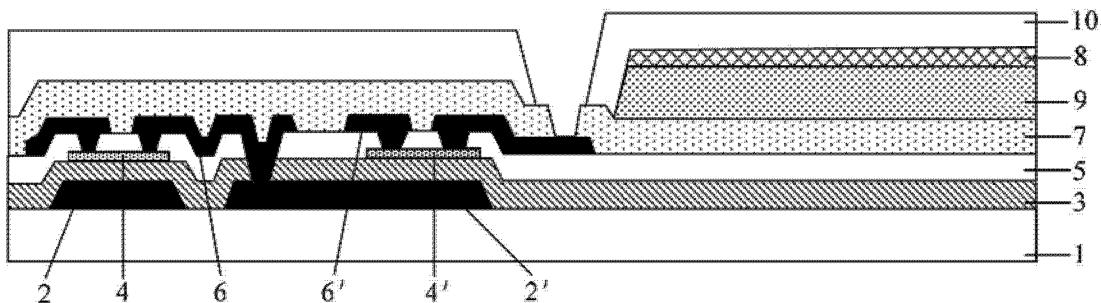


图 10

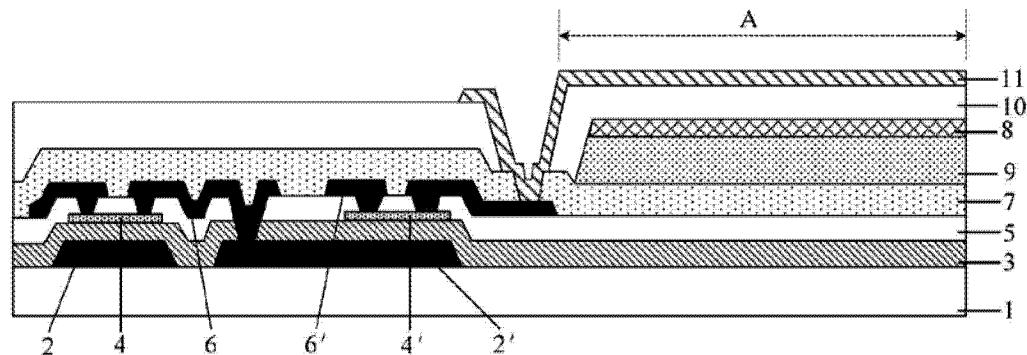


图 11

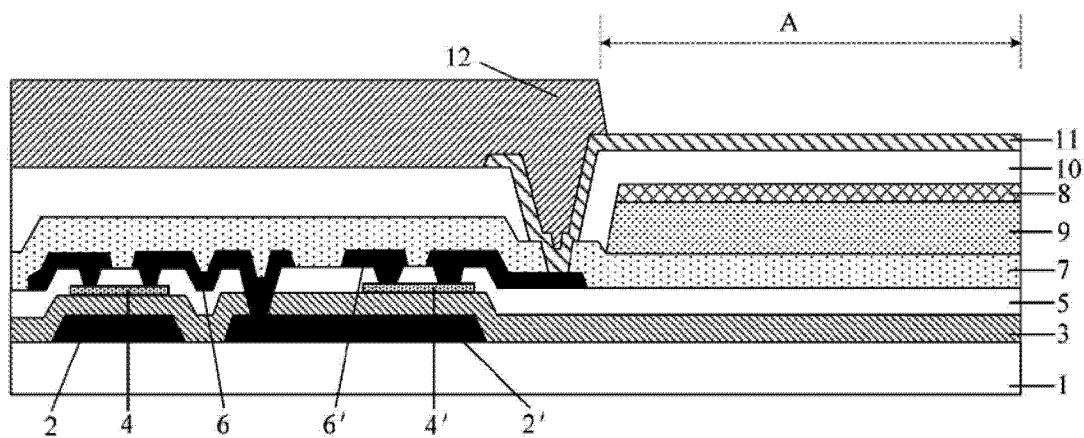


图 12

专利名称(译)	阵列基板及显示装置		
公开(公告)号	CN202930383U	公开(公告)日	2013-05-08
申请号	CN201220686777.4	申请日	2012-12-12
[标]申请(专利权)人(译)	京东方科技股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	京东方科技股份有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	京东方科技股份有限公司		
[标]发明人	宋泳锡 刘圣烈 崔承镇 金熙哲		
发明人	宋泳锡 刘圣烈 崔承镇 金熙哲		
IPC分类号	H01L27/12 H01L27/32		
代理人(译)	王莹		
外部链接	Espacenet Sipo		

摘要(译)

本实用新型公开了一种阵列基板，包括多个位于基板上的像素单元，像素单元包括：形成在基板上的薄膜晶体管结构；以及由薄膜晶体管结构驱动的有机发光二极管，有机发光二极管位于像素单元的像素区域，有机发光二极管在远离基板的方向上依次包括透明的第一电极、发光层、反射光线的第二电极；彩膜，位于所述有机发光二极管与所述薄膜晶体管结构之间；半反半透层，位于所述有机发光二极管的第二电极与所述彩膜之间；有机发光二极管的第二电极与半反半透层形成微腔结构。还公开了包括上述阵列基板的显示装置。本实用新型在阵列基板上实现了结构，制作工艺简单的微腔结构。

